









	<h2 style="color: red;">IPI110N20N3GAKSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI110N20N3GAKSA1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 88A TO262-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IPI110N20N3GAKSA1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI110N20N3GAKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 88A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 270µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 88A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7100pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	87nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	88A (Tc)

IPI110N20N3GAKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI110N20N3GAKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI110N20N3GAKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI110N20N3GAKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI120N04S302AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 120A TO262-3</p>	 <p>IPI111N15N3GAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 83A TO262-3</p>	 <p>IPI11N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 30A I2PAK</p>	 <p>IPI100P03P3L-04 Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 100A TO262-3</p>
 <p>IPI120N04S4-01 INF IPI120N04S4-01 INF</p>	 <p>IPI100N08N3GHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 70A TO262-3</p>	 <p>IPI100N10S305AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>	 <p>IPI100N12S305AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CHANNEL_100+3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI110N20N3GAKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI110N20N3GAKSA1 Datenblatt	IPI110N20N3GAKSA1-Datenblätter	IPI110N20N3GAKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI110N20N3GAKSA1
IPI110N20N3GAKSA1 Electronic	IPI110N20N3GAKSA1-Komponenten	IPI110N20N3GAKSA1-Verteiler	IPI110N20N3GAKSA1-Bild	IPI110N20N3GAKSA1-Teil
IPI110N20N3GAKSA1 Preis	IPI110N20N3GAKSA1 Hersteller	IPI110N20N3GAKSA1 Bild	IPI110N20N3GAKSA1 Aktie	IPI110N20N3GAKSA1 Inventar
IPI110N20N3GAKSA1 Neu	IPI110N20N3GAKSA1 Original	IPI110N20N3GAKSA1 garantiert	IPI110N20N3GAKSA1 RFQ	IPI110N20N3GAKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited